

## Silicon Super Fast Recovery Diode

**$V_{RRM} = 50 \text{ V - } 600 \text{ V}$**   
 **$I_F = 400 \text{ A}$**

### Features

- High Surge Capability
- Types up to 600 V  $V_{RRM}$

**Three Tower Package**



**Maximum ratings, at  $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)**

Parameter	Symbol	Conditions	MURT40040 (R)	MURT40060 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		400	600	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		283	424	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		400	600	V
Continuous forward current	$I_F$	$T_C \leq 125^\circ\text{C}$	400	400	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}, t_p = 8.3 \text{ ms}$	3300	3300	A
Operating temperature	$T_j$		-40 to 175	-40 to 175	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$		-40 to 175	-40 to 175	$^\circ\text{C}$

**Electrical characteristics, at  $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Conditions	MURT40040 (R)	MURT40060 (R)	Unit
Diode forward voltage	$V_F$	$I_F = 200 \text{ A}, T_j = 25^\circ\text{C}$	1.35	1.7	V
Reverse current	$I_R$	$V_R = 50 \text{ V}, T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 50 \text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}$	25 3	25 3	$\mu\text{A}$ mA
<b>Recovery Time</b>					
Maximum reverse recovery time	$T_{RR}$	$I_F=0.5 \text{ A}, I_R=1.0 \text{ A},$ $I_{RR}=0.25 \text{ A}$	180	240	nS
<b>Thermal characteristics</b>					
Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$		0.14	0.14	$^\circ\text{C/W}$

Figure .1- Typical Forward Characteristics

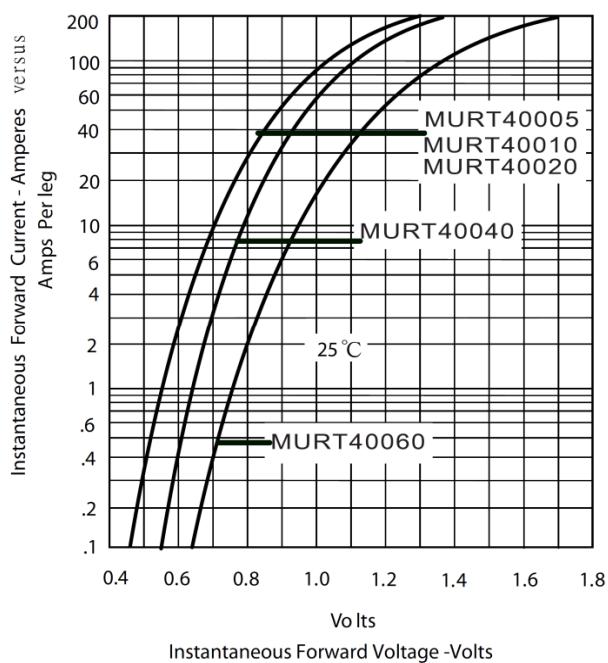


Figure .2- Forward Derating Curve

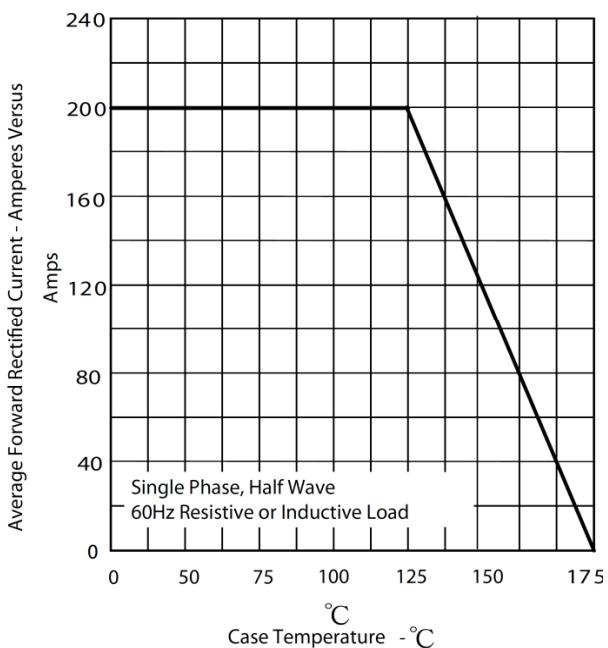


Figure.3- Peak Forward Surge Current

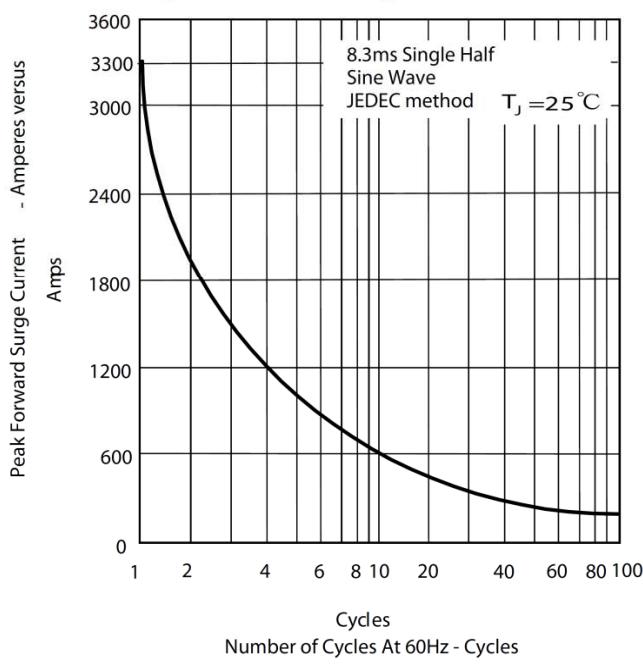
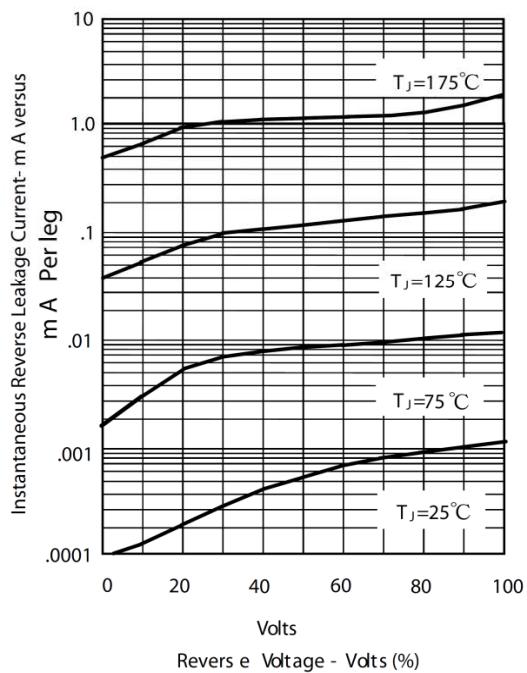


Figure.4- Typical Reverse Characteristics



**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9